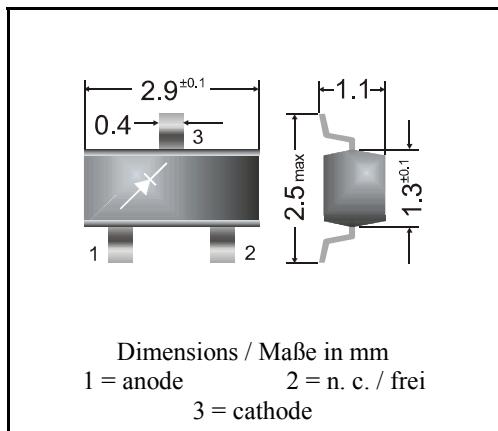


Surface Mount Silicon Planar
Small-Signal Diode
Silizium-Planar-Diode
für die Oberflächenmontage


Nominal current – Nennstrom	250 mA
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	85 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	SOT-23 (TO-236)
Weight approx. – Gewicht ca.	0.01 g
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	see page 18 siehe Seite 18

Maximum ratings**Grenzwerte**

Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	85 V		
Max. average forward current Dauergrenzstrom	I_{FAV}	250 mA ¹⁾		
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	450 mA ¹⁾		
Peak forward surge current Stoßstrom-Grenzwert	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$t_p = 1 \mu\text{s}$	I_{FSM}	2 A
Operating junction temperature – Sperrsichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_j	$-65...+150^\circ\text{C}$	T_s	$-65...+150^\circ\text{C}$

Characteristics**Kennwerte**

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1 \text{ mA}$	V_F	< 715 mV
		$I_F = 10 \text{ mA}$	V_F	< 855 mV
		$I_F = 50 \text{ mA}$	V_F	< 1.0 V
		$I_F = 0.15 \text{ A}$	V_F	< 1.25 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 75 \text{ V}$	I_R	< 1 μA
	$T_j = 150^\circ\text{C}$	$V_R = 25 \text{ V}$	I_R	< 30 μA
	$T_j = 150^\circ\text{C}$	$V_R = 75 \text{ V}$	I_R	< 50 μA

¹⁾ Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß



Junction capacitance
Sperrschiichtkapazität

$$V_F = V_R = 0 \text{ V}$$

$$f = 1 \text{ MHz}$$

$$C_{\text{tot}} < 2 \text{ pF}$$

Reverse recovery time
Sperrverzug

$$I_F = 10 \text{ mA über / through}$$

$$I_R = 10 \text{ mA bis / to } I_R = 1 \text{ mA,}$$

$$U_R = 6 \text{ V, } R_L = 100 \Omega$$

$$t_{\text{rr}} < 6 \text{ ns}$$

Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschiicht – umgebende Luft

$$R_{\text{thA}} < 417 \text{ K/W}^{-1}$$

